

## ТЕРМОДАТЧИКЛАРНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ

**Х.У.Камалов, Д.Г.Бекчанов, Б.П.Жумамуратова**

<sup>1</sup> Қорақалпоқ давлат университети

**Аннотация:** мақолада нанокластерли кремний намуналари асосида термодатчиклар таёrlаши технологияси келтирилган. Шу билан бирга термодатчикларнинг термик коэффициентининг ҳароратга боғликлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

**Калит сўзлар:** кремний, нанокластер, термодатчик, никел, диффузия.

Ҳозирги вақтда дунёда яримўтказгич наноматериалларнинг ҳарорат билан боғлиқ параметрларни тадқиқ этишга катта эътибор берилмоқда. Бу бир қатор илмий тадқиқотлар, жумладан юқори аниқликга эга бўлган термодатчикларни яратиш мақсадида яримўтказгич материалларни легирлаш усулларини такомиллаштириш; физик катталикларни ўлчайдиган датчикларнинг янги турларини яратишида уларнинг имкониятларини очиб бериш; электроника соҳасида кўплаб ишлатилаётган физик катталикларни ўлчайдиган датчикларнинг сезирлигини хамда ташки ҳароратга электрофизик параметрларининг барқарорлигини ошириш усулларини ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади [1].

Кремнийга киришма атомларини диффузия қилиб компенсацияланган материал олиш учун КДБ маркали кремний пластинкалари ишлатилди. Кристалл пластиналардан эни  $1 \times 3 \times 7$  мм бўлган кремний олинди. Кремний намуналари кесиб олинганидан сўнг сирт олди қатламини бузмайдиган эритма HF:HNO<sub>3</sub>:CH<sub>3</sub>COOH керакли нисбатда тайёрланиб олинди ва бу эритма кремний сиртини кимёвий тозалашда ишлатилди.

Танлаб олинган никел киришма атомининг кремнийдаги диффузия коэффиценти катта бўлгани сабабли аввал намуна юзасига ўтиргизиб кейин диффузия қилинди. Диффузия вакуум олинган маълум узунликдаги кварц ампулаларида амалга оширилди. Диффузия учун ўта тоза диффузантлар ишлатилди. Намунанинг солиштирма қаршилигига қараб диффузия ҳарорати  $1000 \div 1200 K$  оралиғида танлаб олинди. Диффузия жараёни босқичма – босқич борувчи паст ҳароратли усулда амалга оширилди [2,3].

Киришма атомларини кремнийга диффузияси қўйдаги формуулалардан фойдаланиб ҳисоблашлар асосида амалга оширилди [6]:

Никел киришма атомларининг диффузия коэффицентини ҳароратга боғлиқлиги қўйдаги формула ёрдамида ҳисобланди.

$$D = 2,3 \cdot 10^{-3} \exp\left(-\frac{0,47}{kT}\right) \quad (1)$$

Никел киришма атомларининг кремнийдаги эрувчанлиги:

$$N_s = 1,4 \cdot 10^{25} \exp\left(-\frac{2,3}{kT}\right) \quad (2)$$

формула ёрдамида ҳисобланади.

Яrimўтказгичларнинг ҳарорат таъсиридаги электрофизик тавсифларини билиш асосида яратиладиган термодатчикларнинг асосий параметрлари ҳарорат сезгирилик коэффициенти  $\beta$  ва қаршиликнинг ҳарорат коэффициенти ҳамда уларни ҳарорат таъсирида ўзгариш тавсифларини аниқлаш мумкин. Ҳароратни ўзгариши билан яrimўтказгич материалларда Ферми сатҳини ўзгаришининг ҳароратга боғлиқлик тавсифи аниқланди[4,5].

Яратилган термодатчикларни асосий ўлчаниб аниқланадиган параметрларига, қаршиликни ҳарорат коэффициенти -  $\alpha$  ва ҳароратни сезгирилик коэффициенти-  $\beta$  бўлиб, улар қўйдаги формулалардан фойдаланиб ҳисобланади:

$$\alpha = \frac{1}{\rho_0} \frac{\Delta \rho}{\Delta T} \quad (3)$$

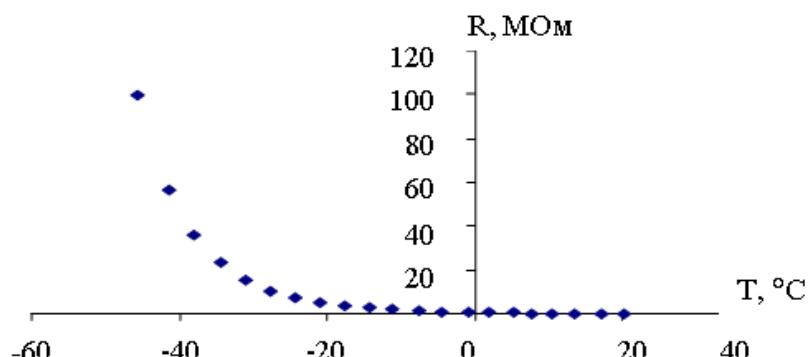
$$\beta = \frac{\ln \rho_0 / \rho}{\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}} \quad (4)$$

бунда:  $\rho_0$  ва  $\rho$  ҳамда  $T_0$  ва  $T$  намуналарнинг ҳарорат тавсифининг ўртача қийматидан олинди. 1-расмда яратилинган термодатчикнинг тузилиши берилди.



**1-расм. Яратилинган терморезисторнинг ташқи куриниши.**

Тажриба натижалари асосида аниқланган, ҳарорат сезгирилик коэффицентини компенсацияланган кремнийни тақиқланган соҳасидаги Ферми сатхини жойлашишга боғлиқ ўзгариши, назарий ҳисобланганидан 10% гача фарқ қилди.



**2-расм. Терморезистор қаршилигини ҳароратнинг  $-60$  –  $+40$   $^{\circ}\text{C}$  оралиғида ўзгариши,  $n\text{-Si} < \text{Ni} >$   $\rho = 10^5$   $\Omega\cdot\text{см}$ .**

Бундан хуоса қиласынан бўлсақ кремний материалига никел атомларин киритиш орқали таёrlанган намуналар асосида термодатчик яратиш мумкинлиги аниқланди.

### Фойдаланган адабиётлар.

1. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика проводников. / М.: Наука. 1990. С.688.
2. Бахадырханов М.К. //Автореферат докторской диссертации.-Л., 1982. С. 22с.
3. Болтакс Б.И.Диффузия в полупроводниках. Наука М.1961.С.421
4. Бахадырханов М.К. Аюпов К.С. Термические свойства кремния с кластерами атомов никеля. Издательство высшего учебного заведения 2008 №12. С.170-172.
5. Насриддинов С.С.// Терморезистор на основе кремния с нанокластерами атомов никеля// Узбекистоннинг инновацион тараккиёти-ёшлар нигохида. Ташкент 2010г. УзНУ.С.155
6. Валиев С.А., Насриддинов С.С., Бахадырханов М.К., Тачилин С.А Чувствительный терморезистори на основе сильнокомпенсированного кремния// Электронная обработка материалов 2007г. С.111-113.